

제20회 한국반도체학술대회

2013년 2월 4일(월)~6일(수) / 웰리힐리파크 (구, 성우리조트)

우) 302-120 대전광역시 서구 둔산동 1018번지 대한빌딩 5층 / 담당: 최은영 팀장, 김아영
TEL: (042) 472 -7461 FAX: (042) 472 -7459 E-mail: kcs@cosar.or.kr

E. Compound Semiconductors 분과

Room F

죽실 (본관, 5층)

2013년 2월 5일(화) 09:30-10:45

[TF1-E] Compound Semiconductor I

좌장: 김해천(한국전자통신연구원)

[초청]

- | | | |
|---------|-------------|--|
| TF1-E-1 | 09:30-10:00 | Alternative Channel III-V/Ge on Si Transistors for POST CMOS Architecture
Jungwoo Oh, Yunwon Song, Seonno Yoon, and Bugeun Ki
School of Integrated Technology, College of Engineering, Yonsei University |
| TF1-E-2 | 10:00-10:15 | First Demonstration of Heterojunction-Free GaN Nanochannel FinFETs
Ki-Sik Im ¹ , Young-Woo Jo ¹ , Ki-Won Kim ¹ , Dong-Seok Kim ¹ , Hee-Sung Kang ¹ , Chul-Ho Won ¹ , Ryun-Hwi Kim ¹ , Sang-Min Jeon ¹ , Dong-Hyeok Son ¹ , Yoo-Mi Kwon ¹ , Jung-Hee Lee ¹ , Jae-Hoon Lee ² , Sorin Christoloveanu ³
¹ School of Electrical Engineering and Computer Science, Kyungpook National University, ² Samsung LED Co., Ltd., ³ IMEP-LAHC, Minatec |
| TF1-E-3 | 10:15-10:30 | 가전용 Application 적용을 위한 6" GaN/Si Normally-off p-GaN Gate HFET의 시뮬레이션과 제작에 관한 연구
이호중, 김웅선, 음영신, 박진홍, 황의진, 김광중, 장태훈
LG전자 Sytem IC 연구소 IGBT part |
| TF1-E-4 | 10:30-10:45 | S-Band 170W Pulsed SSPA using 30W GaN-on-Si RF Power HEMT
강동민, 임종원, 김성일, 이상흥, 이종민, 장우진, 안호균, 민병규, 윤형섭, 주철원, 김해천, 문재경, 남은수
한국전자통신연구원 융합부품소재연구부문 광무선융합부품연구부 RF 융합부품연구팀 |